



Основные технические характеристики транзистора МП20:

Структура транзистора: р-п-р

$P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 200 мВт;

$f_{h21б}$ - Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой: не менее 2 МГц;

$U_{кбо\ проб}$ - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 30 В;

$U_{эбо\ проб}$ - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 30 В;

$I_{к\max}$ и $i_{к\max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 300 мА;

$I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 50 мкА;

$h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно: 50...150;

$R_{кэ\ нас}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 1 Ом